

日程表 (分科別1)

大分類分科名 中分類分科名	3月14日(金)		3月15日(土)		3月16日(日)		3月17日(月)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
S シンポジウム								
NT1【一般公開】就活生必見！あなたならできる半導体のイノベーション ～創造力で新しい時代を～				K103 13:30～16:00				
NT2【一般公開】理工系人材の枯渇危機をどう乗り越えるか？！～15歳からのキャリアパスを考える～						K201 13:30～17:30		
T1 誤り耐性量子コンピュータへの新技術		K103 13:00～17:15						
T2 グリーンファブの未来を拓く：持続可能なものづくりへの挑戦				K206 13:30～18:45				
T3 固体量子ビットを用いた量子科学技術の最前線				K207 13:30～17:45				
T4 地中、水中、生体内、実装した電界感応技術の全員集合が社会を進展			K204 09:30～11:45	K204 13:30～15:30				
T5 非大都市圏に向けた科学・エネルギー教育の展開				K205 13:00～15:30				
T6【一般公開】音と応用物理のコラボレーション					K204 10:00～12:05	K204 13:30～15:45		
T7 化合物半導体を用いた蛍光体開発の現状と展望		K201 13:00～17:30						
T8 植物RIイメージング技術の開発と農業への応用							K201 13:30～16:25	
T9 応用物理の交差点：ガラスとレーザープロセスの新展開				K201 13:30～17:10				
T10 革新的フォトニクスが拓く光学の最前線						K103 13:30～18:05		
T11 放射光利用による先端材料研究開発			K203 10:00～11:25	K203 13:30～17:20				
T12 生物・有機分子ダイナミクスにインスパイアされたセンサ・アクチュエータ機能と創発秩序				K202 13:30～17:55				
T13 次世代トランジスタに向けた新規な機能性酸化半導体チャネル材料・デバイス・作製技術の新展開						K203 13:30～17:40		
T14 プラズマ活性溶液とその応用				K102 13:30～17:40				
T15 原子層プロセス（ALP：Atomic Layer Process）の解析技術と応用技術					K202 09:30～12:00	K202 13:30～17:15		
T16 磁気・スピンをみるイメージング技術を駆使したマグネティックスピントロニクスの新展開						K102 13:30～17:45		
T17 高温超伝導体の新しい潮流～銅酸化物を超える材料は現れるのか？～		K206 13:30～17:25						
T18 有機半導体・ペロブスカイトデバイスの最先端計測	K204 09:00～12:00	K204 13:30～16:15						
T19 ナノテクノロジーを駆使したバイオセンサーと2次元材料の最前線 -セト感染性ウイルスを迅速に検出可能なグラフェンFETセンサーによるパンデミックのない社会の実現-		K205 13:30～17:15						
T20 有機エレクトロニクス技術の現状と将来展望						K204 10:15～12:00	K204 13:30～15:45	
T21 多元系発光材料の新展開 -カルコバイライトからペロブスカイトまで-		K203 13:30～17:35						
T22 次世代半導体創生に向けた研究・人材育成活動シンポジウム		Y1311 14:00～15:30 P10 16:00～18:00						
T23 IoT社会への進展を支える半導体産業のコア技術～融合と多様化～		K101 13:30～16:40						
T24【一般公開】実装技術アラカルトⅡ：最先端半導体実装技術と将来展望				K101 13:30～17:30				
T25 極限環境デバイス				Y1311 13:30～16:45				
T26 極薄物質で本当に良いセンサーができるのか？～ナノチューブ・二次元材料を用いた分子センシングの現状と課題～						K101 13:30～16:55		
T27 カーボンニュートラルを実現する半導体低消費電力化技術の最前線						K205 13:00～17:30		
T28 ナノスケール熱輸送現象と制御の最前線							K205 10:00～11:35	K205 13:00～15:35
T29 マテリアルデータベースの新展開 -知識を蓄積・抽出・俯瞰する-		K102 13:30～16:50						
FS フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」								
FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」		P06 13:30～15:30			K306 09:00～12:00	K306 13:30～16:30	K306 09:00～12:00	K306 13:30～16:45
KS 研究会セッション								
KS.1 固体量子センサ研究会						K503 13:00～15:30 P16 16:00～18:00		
CS.4 6.2 カーボン系薄膜、KS.1 固体量子センサ研究会のコードシェア							K502 09:00～11:30	K502 13:00～15:15
KS.2 量子情報工学研究会	K103 09:00～11:15		K406 09:00～12:00	K406 13:30～16:00		P16 16:00～18:00		
KS.3 半導体グリーンファブ研究会						P16 16:00～18:00		
CS コードシェアセッション								
CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.4 イオンビーム一般のコードシェア						K507 13:00～17:30		
CS.2 3.10 フォトニック構造・現象、3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御のコードシェア				K505 15:45～18:30				
CS.3 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア		K503 13:00～17:45						
CS.4 6.2 カーボン系薄膜、KS.1 固体量子センサ研究会のコードシェア							K502 09:00～11:30	K502 13:00～15:15
CS.5 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェア	K507 09:00～11:30	K507 13:00～18:00						
CS.6 タンデム太陽電池（12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、16.3 シリコン系太陽電池のコードシェア）							K405 09:00～11:45	
CS.7 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア					K402 09:00～11:30			

日程表 (分科別2)

大分類分科名 中分類分科名	3月14日(金)		3月15日(土)		3月16日(日)		3月17日(月)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
1 応用物理学一般								
1.1 応用物理一般・学際領域	K205 10:15 ~ 12:00	P07 16:00 ~ 18:00						
1.2 教育		K310 12:30 ~ 15:30						
1.3 新技術・複合新領域		P07 16:00 ~ 18:00	K205 09:15 ~ 11:45					
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	K209 09:00 ~ 12:00	K209 13:30 ~ 15:15						
1.5 計測技術・計測標準		P07 16:00 ~ 18:00					K209 10:00 ~ 12:00	K209 13:30 ~ 15:45
1.6 超音波				K210 13:30 ~ 16:45				
2 放射線								
2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価	P01 09:30 ~ 11:30		K502 09:00 ~ 11:45	K502 13:00 ~ 17:00	K502 09:00 ~ 11:30	K502 13:00 ~ 16:45		
2.2 発生装置・検出器開発・計測技術						K501 13:00 ~ 18:15	K201 09:00 ~ 11:45	
2.3 加速器技術・加速器質量分析・ビーム分析								
CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.4 イオンビーム一般のコードシェア						K507 13:00 ~ 17:30		
2.4 ライフサイエンス・医療・宇宙地球環境・放射線教育	P01 09:30 ~ 11:30	K502 13:00 ~ 16:15						
3 光・フォトンクス								
3.1 光学基礎・光学新領域		K305 13:30 ~ 17:30	K305 09:00 ~ 12:15	K305 13:30 ~ 17:15	P01 09:30 ~ 11:30			
3.2 情報フォトンクス・画像工学			K508 09:00 ~ 11:15	K508 13:00 ~ 18:15	P02 09:30 ~ 11:30			
3.3 生体・医用光学			K306 09:00 ~ 12:00	K306 13:30 ~ 16:30	P03 09:30 ~ 11:30			
3.4 レーザー装置・材料	K309 09:00 ~ 11:45	K309 13:30 ~ 17:45		P01 13:30 ~ 15:30				
3.5 超高速・高強度レーザー		K308 13:30 ~ 16:30	K308 10:00 ~ 11:45	K308 13:30 ~ 15:50	P04 09:30 ~ 11:30			
3.6 レーザープロセス			P01 09:30 ~ 11:30		K506 09:00 ~ 11:45	K506 13:00 ~ 18:30	K506 09:00 ~ 12:00	
3.7 光計測技術・機器	K304 09:00 ~ 12:15	K304 13:30 ~ 18:30	K304 09:00 ~ 12:15	P02 13:30 ~ 15:30				
				K304 15:45 ~ 19:00				
3.8 テラヘルツ全般		K504 13:00 ~ 16:30	K504 09:15 ~ 11:30	K504 13:00 ~ 17:30	P05 09:30 ~ 11:30			
3.9 光子量子物理・技術			K309 09:30 ~ 11:30	K309 13:30 ~ 16:45				
3.10 フォトニック構造・現象		K505 13:30 ~ 17:30	K505 09:30 ~ 11:45	K505 13:15 ~ 15:30	P06 09:30 ~ 11:30			
CS.2 3.10 フォトニック構造・現象、3.13 シリコンフォトンクス・光電融合集積・光制御のコードシェア				K505 15:45 ~ 18:30				
3.11 ナノ領域光科学・近接場光学	K506 09:00 ~ 11:45	K506 13:15 ~ 18:00	K506 09:00 ~ 11:45	K506 13:15 ~ 18:30	P07 09:30 ~ 11:30	K508 13:00 ~ 14:45		
3.12 半導体光デバイス					P08 09:30 ~ 11:30	K309 13:30 ~ 16:15	K309 10:00 ~ 12:30	
3.13 シリコンフォトンクス・光電融合集積・光制御					P03 13:30 ~ 15:30	K305 13:30 ~ 18:00	K305 09:00 ~ 11:30	K305 13:30 ~ 17:00
CS.2 3.10 フォトニック構造・現象、3.13 シリコンフォトンクス・光電融合集積・光制御のコードシェア					K505 15:45 ~ 18:30			
3.14 Optics and Photonics English Session		K508 13:00 ~ 16:15		P04 13:30 ~ 15:30				
6 薄膜・表面								
6.1 強誘電体薄膜			K503 09:00 ~ 11:15	K503 13:00 ~ 17:00		P08 16:00 ~ 18:00		
CS.3 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア		K503 13:00 ~ 17:45						
6.2 カーボン系薄膜		K403 13:00 ~ 16:45			K403 09:30 ~ 11:15	P09 16:00 ~ 18:00		
CS.4 6.2 カーボン系薄膜、KS.1 固体量子センサ研究会のコードシェア							K502 09:00 ~ 11:30	K502 13:00 ~ 15:15
6.3 酸化物エレクトロニクス	K502 09:30 ~ 11:45	P01 13:30 ~ 15:30			K203 09:00 ~ 11:45		K501 09:30 ~ 11:45	K501 13:00 ~ 15:30
6.4 薄膜新材料		P02 13:30 ~ 15:30				K504 13:00 ~ 17:00	K504 09:30 ~ 11:00	
6.5 表面物理・真空						P10 16:00 ~ 18:00		
CS.5 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェア	K507 09:00 ~ 11:30	K507 13:00 ~ 18:00						
6.6 フローブ顕微鏡					K504 10:00 ~ 11:30	P11 16:00 ~ 18:00	K503 10:00 ~ 11:30	K503 13:00 ~ 16:30
7 ビーム応用								
7.1 X線技術	P02 09:30 ~ 11:30							K507 09:00 ~ 10:45
7.2 電子ビーム応用			K507 09:00 ~ 11:15	K507 13:00 ~ 15:15				
7.3 微細パターン・微細構造形成技術								K507 13:00 ~ 14:45
7.4 イオンビーム一般								
CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.4 イオンビーム一般のコードシェア							K507 13:00 ~ 17:30	
7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術	P02 09:30 ~ 11:30							
CS.5 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェア	K507 09:00 ~ 11:30	K507 13:00 ~ 18:00						

日程表 (分科別3)

大分類分科名 中分類分科名	3月14日(金)		3月15日(土)		3月16日(日)		3月17日(月)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
8 プラズマエレクトロニクス								
8.1 プラズマ生成・診断						P01 13:30 ~ 15:30	K303 09:00 ~ 12:00	K303 13:30 ~ 16:00
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理						P02 13:30 ~ 15:30	K304 09:00 ~ 12:00	K304 13:30 ~ 15:45
8.3 プラズマナノテクノロジー	K201 09:00 ~ 10:45					P03 13:30 ~ 15:30		
8.4 プラズマライフサイエンス	P03 09:30 ~ 11:30				K303 09:00 ~ 11:45	K303 13:30 ~ 16:00		
8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	P04 09:30 ~ 11:30					K304 13:30 ~ 17:15		
8.6 Plasma Electronics English Session						K304 17:15 ~ 17:45		
8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演			K102 10:30 ~ 11:45					
9 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体						K307 13:30 ~ 18:30	P01 09:30 ~ 11:30	
9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート			K307 09:00 ~ 12:30					
9.3 ナノエレクトロニクス					K307 09:00 ~ 11:45			
9.4 熱電変換				K307 13:30 ~ 17:30	K309 10:00 ~ 11:15			
9.5 新機能材料・新物性								K307 13:00 ~ 17:00
10 スピントロニクス・マグネティクス								
10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	K302 10:30 ~ 11:45		K303 09:00 ~ 11:45	K303 13:30 ~ 15:15				
10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	K303 09:00 ~ 11:30	K303 13:30 ~ 17:00						
10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術		K302 13:30 ~ 17:15		P07 16:00 ~ 18:00				
10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス								K102 13:30 ~ 16:45
10.5 磁場応用					K102 09:00 ~ 11:15			
11 超伝導								
11.1 基礎物性	P05 09:30 ~ 11:30		K209 10:15 ~ 11:30	K209 13:30 ~ 16:45				
11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長						K206 13:00 ~ 15:15		
11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用						K206 09:00 ~ 10:45		
11.4 アナログ応用および関連技術						K209 13:30 ~ 18:00		
11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用						K209 09:00 ~ 12:00		
12 有機分子・バイオエレクトロニクス								
12.1 作製・構造制御		K406 13:00 ~ 17:15				P04 13:30 ~ 15:30		
12.2 評価・基礎物性		K404 13:30 ~ 18:00	K404 09:00 ~ 12:15	K404 13:45 ~ 18:45		P05 13:30 ~ 15:30		
12.3 機能材料・萌芽的デバイス			P02 09:30 ~ 11:30		K406 09:00 ~ 11:30	K406 13:00 ~ 17:45	K406 09:00 ~ 11:30	K406 13:00 ~ 15:15
12.4 有機EL・トランジスタ			P03 09:30 ~ 11:30			K404 13:00 ~ 16:00		K404 13:00 ~ 16:30
12.5 有機・ハイブリッド太陽電池		P08 16:00 ~ 18:00	K405 09:00 ~ 12:00	K405 13:00 ~ 17:15	K405 09:00 ~ 11:30	K405 13:00 ~ 17:00		K405 13:00 ~ 15:15
CS.6 タンデム太陽電池 (12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、16.3 シリコン系太陽電池のコードシェア)							K405 09:00 ~ 11:45	
12.6 ナノバイオテクノロジー			P04 09:30 ~ 11:30			K402 13:00 ~ 17:15	K402 09:00 ~ 11:30	K402 13:00 ~ 16:00
CS.7 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア					K402 09:00 ~ 11:30			
12.7 医用工学・バイオチップ			P05 09:30 ~ 11:30	K403 14:30 ~ 18:45		K403 13:00 ~ 16:45	K403 09:00 ~ 11:30	K403 13:00 ~ 16:45
CS.7 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア					K402 09:00 ~ 11:30			
12.8 特定テーマ: 有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御			K402 09:00 ~ 11:15	K402 13:00 ~ 15:30			P02 09:30 ~ 11:30	
13 半導体								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション			K509 10:00 ~ 11:30	K509 13:30 ~ 15:15				
				P08 16:00 ~ 18:00				
13.2 探索的材料物性・基礎物性	K210 09:00 ~ 11:30	K210 13:30 ~ 16:00				P12 16:00 ~ 18:00		
13.3 絶縁膜技術						P13 16:00 ~ 18:00	K202 09:30 ~ 11:45	K202 13:00 ~ 14:45
CS.3 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア		K503 13:00 ~ 17:45						
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術				P09 16:00 ~ 18:00	K103 09:00 ~ 11:45		K103 09:00 ~ 12:00	K103 13:30 ~ 16:00
13.5 デバイス/配線/集積化技術	K101 09:00 ~ 12:15		K101 09:00 ~ 12:00	P10 16:00 ~ 18:00	K508 09:00 ~ 12:00		K101 09:00 ~ 12:30	K101 13:30 ~ 16:45
CS.3 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア		K503 13:00 ~ 17:45						
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス						P14 16:00 ~ 18:00	K302 10:00 ~ 11:30	K302 13:30 ~ 16:00
13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価		P03 13:30 ~ 15:30	K403 09:00 ~ 12:45		K301 09:00 ~ 12:30	K301 14:00 ~ 17:30	K301 09:00 ~ 11:45	K301 13:15 ~ 17:00

日程表 (分科別4)

大分類分科名 中分類分科名	3月14日(金)		3月15日(土)		3月16日(日)		3月17日(月)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13.8 光物性・発光デバイス				P11 16:00 ~ 18:00	K302 10:00 ~ 11:30	K302 13:30 ~ 15:00		
13.9 化合物太陽電池			K302 09:00 ~ 12:00	K302 13:30 ~ 16:30		P15 16:00 ~ 18:00		
CS.6 タンデム太陽電池 (12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、16.3 シリコン系太陽電池のコードシェア)							K405 09:00 ~ 11:45	
15 結晶工学								
15.1 バルク結晶成長							K310 09:30 ~ 12:00	
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶						P06 13:30 ~ 15:30		K310 13:30 ~ 14:00
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎		P04 13:30 ~ 15:30			K310 09:30 ~ 11:30	K310 13:30 ~ 14:45		
15.4 III-V族窒化物結晶	K401 09:00 ~ 11:30	K401 13:00 ~ 17:30	K401 09:00 ~ 11:30	K401 13:00 ~ 17:30	K401 09:00 ~ 11:30	K401 13:00 ~ 17:30	K401 09:00 ~ 12:00	
		P05 13:30 ~ 15:30						
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶			K310 10:00 ~ 12:00	K310 14:00 ~ 16:15		P07 13:30 ~ 15:30		
15.6 IV族系化合物 (SiC)		K402 13:00 ~ 15:45						
15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	K306 09:00 ~ 11:45	K306 13:30 ~ 14:15						
		P09 16:00 ~ 18:00						
16 非晶質・微結晶								
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス							K308 09:30 ~ 11:30	K308 13:30 ~ 16:45
16.2 エナジーハーベスティング			P06 09:30 ~ 11:30		K205 09:00 ~ 10:30			
16.3 シリコン系太陽電池					K308 09:00 ~ 11:30	K308 13:30 ~ 17:15		
CS.6 タンデム太陽電池 (12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、16.3 シリコン系太陽電池のコードシェア)							K405 09:00 ~ 11:45	
17 ナノカーボン・二次元材料								
17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料		K207 13:30 ~ 19:00						
17.2 グラフェン			K207 09:00 ~ 12:00	P05 13:30 ~ 15:30	K207 09:00 ~ 11:45			
17.3 層状物質		K301 13:30 ~ 18:15	K301 09:00 ~ 12:00		K101 09:00 ~ 12:00		K102 09:30 ~ 11:45	
				K301 15:45 ~ 19:00				
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」								
21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」				P12 16:00 ~ 18:00	Y1311 09:00 ~ 11:30	Y1311 13:00 ~ 17:15	Y1311 09:00 ~ 11:45	Y1311 13:00 ~ 15:45
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」								
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」			K501 10:00 ~ 11:15	K501 13:00 ~ 16:30	P09 09:30 ~ 11:30			
23 合同セッションN「インフオマティクス応用」								
23.1 合同セッションN「インフオマティクス応用」				P06 13:30 ~ 15:30	K505 09:00 ~ 11:30	K505 13:00 ~ 17:45	K505 09:00 ~ 11:30	K505 13:00 ~ 16:30